

Title (en)

Improved high-voltage circuit breaker with gas release

Title (de)

Hochspannungs-Schutzschalter mit verbessertem Gasaustritt

Title (fr)

Disjoncteur haute tension à échappement de gaz amélioré

Publication

**EP 2063445 A1 20090527 (FR)**

Application

**EP 08169248 A 20081117**

Priority

FR 0759228 A 20071122

Abstract (en)

The method involves inhaling insulating gas (GI) from an interior of a cover (3) to mix the insulating gas and hot gases (GC) at the interior of the cover before evacuation of the hot gases through gas exit openings (30) of the cover towards an interior of a metallic tank. The inhaling of the insulating gas is carried out parallel to entire flow of the hot gases that are issued from an interrupter of a high voltage circuit breaker, where the tank of the circuit breaker is filled with the insulating gas. An independent claim is also included for a high voltage circuit breaker comprising a metallic tank.

Abstract (fr)

L'invention concerne un procédé d'évacuation de gaz chauds issus d'une coupure d'un disjoncteur (1) haute tension comprenant une cuve métallique (2) remplie de gaz isolant, une enveloppe (3) comprenant des ouvertures (30) de sortie de gaz et agencée à l'intérieur de la cuve métallique (2) en communiquant avec les ouvertures, caractérisé en ce qu' on aspire du gaz isolant (GI) depuis l'intérieur de l'enveloppe (3), parallèlement à la totalité de flux de gaz chauds (GC) issus de la coupure, de sorte à les mélanger à l'intérieur de l'enveloppe (3) avant leur évacuation par les ouvertures (30) de sortie de gaz de l'enveloppe vers l'intérieur de la cuve métallique (2). L'invention concerne également un disjoncteur haute tension associé, qui comprend des moyens d'aspiration (5) de gaz isolant depuis l'intérieur de l'enveloppe (3), parallèlement à la totalité de flux de gaz chauds.

IPC 8 full level

**H01H 33/70** (2006.01); **H01H 33/74** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**H01H 33/7015** (2013.01 - EP US); **H01H 33/74** (2013.01 - EP US); **H01H 2033/888** (2013.01 - EP US)

Citation (applicant)

- JP 2003217411 A 20030731 - TOSHIBA CORP
- EP 1806760 A1 20070711 - AREVA T & D SA [FR]
- US 4236053 A 19801125 - ASAI YOSHIHITO [JP], et al
- DE 9314779 U1 19931125 - SIEMENS AG [DE]
- DE 2947957 A1 19801204 - SPRECHER & SCHUH AG
- EP 1185996 B1 20030910 - SIEMENS AG [DE]

Citation (search report)

[X] EP 1768150 A1 20070328 - ABB TECHNOLOGY AG [CH]

Cited by

CN110828228A

Designated contracting state (EPC)

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

Designated extension state (EPC)

AL BA MK RS

DOCDB simple family (publication)

**EP 2063445 A1 20090527**; **EP 2063445 B1 20170104**; FR 2924267 A1 20090529; US 2009134123 A1 20090528; US 8530774 B2 20130910

DOCDB simple family (application)

**EP 08169248 A 20081117**; FR 0759228 A 20071122; US 27074608 A 20081113